1. **S. Shimomura, T. Toritsuka, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** 1.3μm range effectively cylindrical In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As quantum wires grown on (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.32,** *No.1-2,* 346-349, 2006.
2. **Y. Higuchi, S. Osaki, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Takasuka, M. Ogura *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing of GaAs quantum wire vertical-cavity surface-emitting lasers grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *Solid-State Electronics,* **Vol.50,** *No.6,* 1137-1140, 2006.
3. **Jun Inoue, Toshiro Isu, Kouichi Akahane *and* Masahiro Tsuchiya :** Saturable absorption of highly stacked InAs quantum dot layer in 1.5 μm band, *Applied Physics Letters,* **Vol.89,** *No.15,* 151117, 2006.
4. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Yamashita, A. Endoh, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Velocity enhancement in cryogenically cooled InP-based HEMTs on (411)A-oriented substrates, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.53,** *No.11,* 2842-2846, 2006.
5. **H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura, S. Hiyamizu, I. Watanabe, T. Matsui *and* T. Mimura :** Suppression of surface segregation of silicon dopants during molecular beam epitaxy of (411)A In0.75Ga0.25As/In0.52Al0.48As pseudomorphic high electron mobility transistor structures, *Journal of Vacuum Science & Technology B,* **Vol.24,** *No.6,* 2668-2671, 2006.
6. **Yu Higuchi, Shinji Osaki, Yoshifumi Sasahata, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Mutsuo Ogura *and* Satoshi Hiyamizu :** 830-nm Polarization Controlled Lasing of InGaAs Quantum Wire Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers Grown on (775)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.7,* L138-L141, 2007.
7. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Selective generation of quantum beats of weakly confined excitons, *Proceedings of International conference on physics of semiconductors,* **Vol.3,** 78, Viena, Austria, Jul. 2006.
8. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Enhancement of nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films by spectrally rectangle-shape-pulse-excitation, *International conference on nanoscience and technology,* **Vol.600,** 164, Basel, Switzerland, Jul. 2006.
9. **Y. Sasahara, S. Osaki, T. Fujita, A. Uenishi, T. Toritsuka, K. Ohmori, Y. Higuchi, K. Miyajima, Takahiro Kitada, S. Shimomura, T. Itoh *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing action of vertical cavity surface emitting laser with self-organized InGaAs quantum wire grown on the (775)B InP substrates by molecular beam epitaxy, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 31, The University of British Columbia, Vancouver, Canada, Aug. 2006.
10. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 113, Vancouver, Aug. 2006.
11. **Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 30, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
12. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, A. Endoh, Y. Yamashita, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs fabricated on (411)A-oriented substrates by MBE, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 166, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
13. **S. Shimomura, T. Toritsuka, K. Ohmori, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** Room temperature operation of 1.2um range self-organized quantum wire lasers grown on a (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 327, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
14. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** High Schottky AlAs barriers inserted into pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with (411)A super-flat interfaces grown by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 70, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
15. **S. Osaki, Y. Higuchi, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 89, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
16. **T. Fujita, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Gain spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 90, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
17. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear optical response of weakly confined excitons, *Kobe Frontier Technology Forum,* 38, Kobe, Nov. 2006.
18. **A. Kanno, Toshiro Isu, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *5th International Symposium on Nanotechnology,* **Vol.P3-18,** *No.176,* Tokyo, Feb. 2007.
19. **Toshiro Isu, J. Inoue, K. Akahane, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear absorption of highly stacked InAs quantum dot layers on an InP(311) substrate, *Proceedings of SPIE,* **Vol.6393,** 639309-1-639309-9, Washington, D.C., Mar. 2007.
20. **T. Fujita, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Gain Spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser groun on (775)B GaAs substrates by moleclar beam epitaxy, *25th Electron Material Symposium,* 306-307, 2006年7月.
21. **S. Osaki, Y. Higuchi, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 316-317, 2006年7月.
22. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with high Schottky AlAs barriers grown on (411)A InP substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 82-83, 2006年7月.
23. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons, *25th Electron Material Symposium,* Jul. 2006.
24. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の超高速非線形光学応答, *応用物理学会中国四国支部学術講演会,* 2006年7月.
25. **楠 真一郎, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (411)A InGaAs/InAlAs変調ドープ歪量子井戸構造における異方性評価, *第67回応用物理学会学術講演会,* 287, 2006年8月.
26. **下村 哲, 笹畑 圭史, 大森 和幸, 鳥塚 哲郎, 上西 敦士, 北田 貴弘, 小倉 睦郎, 冷水 佐壽 :** 自己形成型量子細線のMBE成長とレーザ·面発光レーザへの応用, *第67回応用物理学会学術講演会,* 30, 2006年8月.
27. **尾崎 信二, 樋口 裕, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線のフォトルミネッセンス温度依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
28. **藤田 剛也, 大森 和幸, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線レーザの利得スペクトル, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
29. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子による超高速非線形光学応答, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
30. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜における弱閉じ込め励起子の量子ビート, *日本物理学会2006年秋季大会,* 2006年9月.
31. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜閉じ込め励起子の時間分解分光, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
32. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子による非線形光学応答, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
33. **石川 陽, 井須 俊郎, 石原 一 :** 共振器QED系での励起子分子効果による2光子非線形性の理論, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
34. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 土屋 昌弘 :** 超高速光スイッチに向けたGaAs系弱閉じ込め励起子の光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
35. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 励起レーザスペクトル制御による弱閉じ込め励起子の非線形光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
36. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs 弱閉じ込め励起子の時間分解フォトルミネッセンス, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
37. **R. Katouf, A. Kanno, O. Kojima, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs Based devices by wafer fusion, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* Mar. 2007.
38. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクス, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
39. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の非線形光学応答に対する励起子準位間干渉効果, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
40. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子非線形光学応答の複数準位励起効果, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
41. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の光学応答, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
42. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Effects of Heterointerface Flatness on Device Performance of InP-Based High Electron Mobility Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.4B,* 2325-2329, 2007.
43. **Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura *and* Satoshi Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 172-176, 2007.
44. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs on(411)A-oriented substrates by MBE, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 1025-1029, 2007.
45. **Yusuke Kondo, Masaaki Ono, Shunichirou Matsuzaka, Ken Morita, Haruki Sanada, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Multi Pulse Operation and Optical Detection of Nuclear Spin Coherence in a GaAs/AlGaAs Quantum Wells, *Physical Review Letters,* **Vol.101,** *No.20,* 207601, 2008.
46. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.1,* 360-363, 2008.
47. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 963-965, 2008.
48. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 966-968, 2008.
49. **A. Kanno, R. Katouf, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 1069-1071, 2008.
50. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.5,* 1731-1734, Weinheim, May 2007.
51. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Sasaki, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.Mo-P7-08,** 80, Segovia, Jun. 2007.
52. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-49,** 255, Segovia, Jun. 2007.
53. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, R Katouf, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-50,** 256, Segovia, Jun. 2007.
54. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs, *15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors(HCIS15),* **Vol.WeA-3,** Tokyo, Jul. 2007.
55. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.MoD P1,** 81, Kyoto, Oct. 2007.
56. **N Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P6,** 341, Kyoto, Oct. 2007.
57. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P5,** 340, Kyoto, Oct. 2007.
58. **井須 俊郎, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(311)B上のInAs量子ドットの光学異方性, *第3回量子ナノ材料セミナー,* 1-4, 2007年6月.
59. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Interference effects on degenerate four-wave-mixing signals by weakly confined exciton states, *26th Electron Material Symposium, No.G5,* 159-160, Jul. 2007.
60. **T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada, K Akahane, N Yamamoto *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of InAs quantum dots on an InP(113)B substrate, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G6,** 161-162, Jul. 2007.
61. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Dynamics of excitons weakly confined in GaAs thin films by time-resolved photoluminescence measurements, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G7,** 162-163, Jul. 2007.
62. **井須 俊郎 :** 光電場のナノ空間構造を利用した超高速光スイッチの開発, *ナノテクデバイス研究会,* 68-69, 2007年7月.
63. **Kojima O., Toshiro Isu, Ishi-Hayase J., Kanno A., Katouf R., Sasaki M. *and* Tsuchiya M. :** Interference effects between weakly confined exciton states on exciton dephasing, *ナノテクデバイス研究会,* 126-127, Jul. 2007.
64. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクスおよび，光カー効果を用いた全光スイッチ応用の検討, *ナノテクデバイス研究会,* 128-129, 2007年7月.
65. **Katouf R., Kanno A., Kojima O., Ishi-Hayase J., Tsuchiya M. *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs based photonic devices by wafer fusion, 130-131, Jul. 2007.
66. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** PLによる高指数面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-5,** 92, 2007年8月.
67. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答を実現するGaAs/AlAs多層膜構造の検討, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-6,** 93, 2007年8月.
68. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克, 井須 俊郎 :** (113)B InAs量子ドットのフォトルミネッセンスによる光学異方性, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-7,** 94, 2007年8月.
69. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子系の非線形光学応答に対する残留キャリア効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.4a-ZK-12,** 1461, 2007年9月.
70. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B上の積層InAs量子ドットの光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.6a-N12,** 1413, 2007年9月.
71. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜構造における光電場強度の増大効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-2,** 1418, 2007年9月.
72. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数(11n)面上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-3,** 1418, 2007年9月.
73. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 弱閉じ込め励起子系における光カー効果のピコ秒応答, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-4,** 1419, 2007年9月.
74. **北田 貴弘, 楠 慎一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** (411)A InGaAs/InAlAs 変調ドープ歪量子井戸構造における界面ラフネスの異方性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.8a-H-2,** 345, 2007年9月.
75. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の配向緩和, *日本物理学会第62回年次大会,* **Vol.23pPSA-91,** 769, 2007年9月.
76. **岩見 勝弘, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎 :** フェムト秒レーザー照射に伴う4H-SiC上での電気伝導度変化の検討, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.16,** 129-130, 2007年11月.
77. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子のサブピコ秒光カー効果, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-48,** 191-194, 2007年12月.
78. **渡辺 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** スペクトル分解反射型ポンプ・プローブ法によるGaAs薄膜中閉じ込め励起子の過渡応答測定, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-47,** 187-190, 2007年12月.
79. **北田 貴弘, 森田 健, 井須 俊郎 :** 面型超高速光スイッチに向けた半導体多層膜のMBE成長, *応用物理学会中国四国支部研究会,* 2007年12月.
80. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2007年12月.
81. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B基板上InAs量子ドットのフォトルミネッセンス光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-11,** 2007年12月.
82. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数GaAs面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-12,** 2007年12月.
83. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答のためのGaAs/AlAs 多層膜構造の光電場強度増大効果, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-13,** 2007年12月.
84. **北田 貴弘, 楠 真一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** 電子移動度によるInGaAs/InAlAs へテロ界面の異方性評価, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-14,** 2007年12月.
85. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, Katouf Redouane, 菅野 敦史, 土屋 昌弘 :** GaAs閉じ込め励起子ポラリトンによる超高速光スイッチ, *JSTナノテクノロジー分野別バーチャルラボ成果報告会,* PB6-1, 2008年1月.
86. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における複数準位励起下での閉じ込め励起子の過渡反射スペクトル, *日本物理学会第63回年次大会, No.26a-PS-27,* 2008年3月.
87. **カトフ レドワン, 菅野 敦史, 山本 直克, 井須 俊郎, 外林 秀之, 土屋 昌弘 :** GaAs ナノ細線光導波路の作製と評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
88. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs (001)および(113)B基板上へのInAs量子ドットのMBE成長と光学特性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
89. **森田 健, 神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜における時間分解非線形光学応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
90. **小島 磨, 宮川 歩弓, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の超高速非線形応答の励起光強度依存性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
91. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 有限障壁ポテンシャルを考慮した高指数GaAs (11n)A基板上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
92. **神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** AlAs/Al0.3Ga0.7Asダブルエッチストッパー構造を有するGaAs/AlAs多層膜構造の作製, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
93. **北田 貴弘, 神原 敏之, 森田 健, 井須 俊郎 :** マトリックス法によるGaAs/AlAs多層膜構造の光カー信号強度のシミュレーション, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
94. **菅野 敦史, カトフ レドワン, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 多連パルス入射時の弱閉じ込め励起子光カー効果サブピコ秒応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
95. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast response induced by interference effects between weakly confined exciton states, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.77,** *No.4,* 044701, 2008.
96. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, 2008.
97. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2753-2755, 2008.
98. **Nobuyoshi Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2756-2759, 2008.
99. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs Multilayer Cavity with Self-Assembled InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Ultrafast All-Optical Switching Applications, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.9,* 092302, 2008.
100. **Takahiro Kitada, Nobuyoshi Niki, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of(11n)-Oriented InGaAs Strained Quantum Wells with Finite Barrier Potential Calculated with Mixing Effects of the Spin-Orbit Split-Off Band, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.10,* 7839-7841, 2008.
101. **R. Katouf, N. Yamamoto, A. Kanno, N. Sekine, K. Akahane, H. Sotobayashi, Toshiro Isu *and* M. Tsuchiya :** Ultrahigh Relative Refractive Index Contrast GaAs Nanowire Waveguides, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.12,* 122101, 2008.
102. **Osamu Kojima, Ayumi Miyagawa, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Ultrafast all-optical control of excitons confined in GaAs thin films, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.11,* 112401, 2008.
103. **Ken Morita, Kanbara Toshiyuki, Yano Shinsuke, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with /2 phase shift layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.1,* 137-140, 2009.
104. **O Kojima, A Miyagawa, T Kita, Toshiro Isu *and* O Wada :** Optical Cancellation of exciton population in GaAs thin films, *3rd International Laser, Light-Wave and Microwave Conference 2008,* **Vol.24-TP1-1,** Yokohama, Apr. 2008.
105. **R. Katouf, A. Kanno, N. Yamamoto, N. Sekine, K.T. Liang, K. Sasagawa, K. Akahane, Toshiro Isu, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** 15 dB cross loss modulation by cw pump injection of mW-class in 1.5-mm long nano-wire waveguide, *Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO2008),* San Jose, U.S.A., May 2008.
106. **Ken Morita, Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with λ/2 phase shift layer, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.OP-IV-03,** Kyoto, Jun. 2008.
107. **O. Kojima, A. Miyagawa, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Optical control of residual excitons for ultrafast nonlinear response in GaAs thin films, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.P-53,** Kyoto, Jun. 2008.
108. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, Jul. 2008.
109. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Third International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications,* Edmonton, Canada, Jul. 2008.
110. **Takahiro Kitada, T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2008), No.3-V FA1.6,* Vancouver, Aug. 2008.
111. **T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-1-4,** Tsukuba, Sep. 2008.
112. **T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-2-5,** Tsukuba, Sep. 2008.
113. **T. Takahashi, .T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular beam epitaxy of self-assembled InAs quantum dots on (001) and (113)B GaAs substrates under a slow growth rate condition, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.F-5-2,** Tsukuba, Sep. 2008.
114. **Ken Morita, T. Kanbara, S. Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *35th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2008),* **Vol.P35,** Rust,Germany, Sep. 2008.
115. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-resolved two-photon absorption measurements of GaAs/AlAs multilayer with λ/2 GaAs layer, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J13,* 211, Jul. 2008.
116. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication and optical properties of self-assembled InAs quantum dots grown on GaAs(001) and (113)B substrates, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.K9,* 235, Jul. 2008.
117. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation effect on transient response of excitons confined in GaAs thin films, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J14,* 213, Jul. 2008.
118. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長と光学特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-05,** 2008年8月.
119. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製と二光子吸収特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-07,** 2008年8月.
120. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs 量子井戸の二光子励起フォトルミネッセンス, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-05,** 2008年8月.
121. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs 基板上InAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長とフォトルミネッセンス測定, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-06,** 2008年8月.
122. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造におけるQ値と光カー信号強度, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-09,** 2008年8月.
123. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットのMBE成長, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(2a-CF-16),* 2008年9月.
124. **今津 晋二郎, 松木 豊和, 毛利 如良, 藤田 剛也, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (775)B GaAs基板上にMBE成長したGaAs/(GaAs)4(AlAs)2自己形成型量子細線レーザのゲインスペクトル3, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3p-ZQ-6),* 2008年9月.
125. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子共鳴量子井戸を有するGaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-2),* 2008年9月.
126. **森田 健, 神原 敏之, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器の非対称時間分解光カー信号, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-3),* 2008年9月.
127. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造における光カー信号強度の層数依存性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-4),* 2008年9月.
128. **北田 貴弘, 神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の光カー信号強度のQ 値依存性のシミュレーション, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-5),* 2008年9月.
129. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (001)量子井戸における二光子吸収の光学異方性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-6),* 2008年9月.
130. **小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の密度制御, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-7),* 2008年9月.
131. **岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎, 齋藤 伸吾 :** フェムト秒レーザー照射により改質されたSiCの電気伝導特性, *第69回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.69,** *No.3,* 999, 2008年9月.
132. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの高速キャリア緩和, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(4p-ZQ-16),* **Vol.Ep-05,** 2008年9月.
133. **森田 健, 仁木 伸義, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子励起フォトルミネッセンス分光におけるGaAs/AlGaAs量子井戸の光学異方性, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-100,** 402-405, 2008年12月.
134. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子ポラリトン伝播効果, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-105,** 422-425, 2008年12月.
135. **向所 明里, 向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As 層に埋め込んだInAs量子ドットの作製とその光学特性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-2,* 2009年1月.
136. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs量子井戸における二光子吸収の偏光方向異方性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-3,* 2009年1月.
137. **熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** 100kHzフェムト秒レーザーを用いた半導体へのナノ周期構造の作製, *レーザー学会学術講演会第29回年次大会講演予稿集,* **Vol.29,** 125, 2009年1月.
138. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製に向けて, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
139. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットのMBE成長, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
140. **森田 健 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造の非線形光学応答, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
141. **小島 磨, 渡部 真吾, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子過渡応答に対する空間コヒーレンス効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
142. **井須 俊郎, 田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘 :** 2つの共振器モードを実現するGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
143. **田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造における第二高調波・和周波発生, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
144. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和InGaAsバリア層に埋め込んだInAs量子ドットのキャリア緩和におけるドーピング効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
145. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 共振器層に過飽和吸収特性を有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
146. **森田 健, 高橋 朋也, 神原 敏之, 向井 拓也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層中のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器における光カー信号, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
147. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器のMBE成長, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
148. **小島 磨, 井須 俊郎 :** Dynamics of Excitons Confined in Semiconductor Thin Films, High-Power and Femtosecond Lasers : Properties, Materials and Applications (Lasers and Electro-optics Research and Technology), 2009年7月.
149. **Ken Morita, Haruki Sanada, Shunichirou Matsuzaka, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Intersubband exchange interaction induced by optically excited electron spins in GaAs/AlGaAs quantum wells, *Applied Physics Letters,* **Vol.94,** *No.16,* 162104, 2009.
150. **Shingo Watanabe, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.S1,* S139-S142, 2009.
151. **Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C106, 2009.
152. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C105, 2009.
153. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Properties of Self-Assembled InAs Quantum Dots Grown on (001) and (113)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy under a Slow Growth Rate Condition, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C128, 2009.
154. **Ken Morita, Toshiyuk Kanbara, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1420-1423, 2009.
155. **Takahiro Kitada, Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.311,** *No.7,* 1807-1810, 2009.
156. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked Enhancement of Optical Kerr Signal in Proportion to Fourth Power of Quality Factor of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.8,* 080203, 2009.
157. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced Optical Kerr Signal of GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers, *Applied Physics Express,* **Vol.2,** *No.8,* 082001, 2009.
158. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures for terahertz emission devices, *Applied Physics Letters,* **Vol.95,** *No.11,* 111106, 2009.
159. **Takuro Tomita, Masahiro Iwami, Minoru Yamamoto, Manato Deki, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shingo Saito, Kiyomi Sakai, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Electronic properties of femtosecond laser induced modified spots on single crystal silicon carbide, *Materials Science Forum,* **Vol.645-648,** 239-242, 2010.
160. **Atsushi Kanno, Redouane Katouf, Osamu Kojima, Junko Ishi-Hayase, Masahiro Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr response to multi pump pulses on GaAs weakly confined exciton, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1509-1512, Wiley-VCH, Apr. 2009.
161. **Takahiro Kitada, A. Mukaijyo, T. Takahashi, T. Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP54,** 66, Kobe, Jul. 2009.
162. **Ken Morita, T. Takahashi, T. Kanbara, S. Yano, T. Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP59,** 71, Kobe, Jul. 2009.
163. **S. Shimomura, T. Fujita, S. Imadu *and* Takahiro Kitada :** Anisotropic modal gain spectra of GaAs self-assembled quantum-wire laser structures on (775)B GaAs substrates, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Tu-mP27,** 141, Kobe, Jul. 2009.
164. **O. Kojima, S. Watanabe, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Spatial coherence effect on transient response of confined excitons in GaAs thin films, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Th-mP7,** 226, Kobe, Jul. 2009.
165. **Ken Morita, H. Sanada, S. Matsuzaka, Y. Ohno *and* H. Ohno :** Two-color pump-probe measurements of intersubband excitonic interactions in GaAs/AlAs quantum wells, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.M6e,** 204, Kobe, Jul. 2009.
166. **Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular Beam Epitaxy of InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.P-19,** Annan, Aug. 2009.
167. **Toshiro Isu, Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr Signals of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.O-12,** Annan, Aug. 2009.
168. **Toshiro Isu, Kanbara Toshiyuki, Takahashi Tomoya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.15,* 123, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
169. **Ken Morita, Niki Nobuyoshi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.13,* 119, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
170. **Takahashi Tomoya, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers for planar-type optical Kerr gate switches, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-6-5,** Sendai, Oct. 2009.
171. **Tanaka Fumiya, Takahashi Tomoya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong sum frequency generation in a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity grown on a (113)B-oriented GaAs substrate, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-9-2,** Sendai, Oct. 2009.
172. **Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Yoshinori Nakagawa, Masuo Fukui, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication of a grating coupler in surface plasmon polariton (SPP) waveguide by scanning probe microscope (SPM) lithography, *Abstract of the 7-th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO-7),* 70, Jeju, Nov. 2009.
173. **Takae Yamashita, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Effective dipole moments of excitons in GaAs thin films, *Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2009 (WINPTech 2009),* Kobe, Dec. 2009.
174. **野村 英矩, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** シリコン表面上で生成されるリップル構造のパルス数及びフルエンス依存性, *第56回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.56,** *No.3,* 1180, 2009年4月.
175. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** プローブ陽極酸化リソグラフィー法による微細グレーティング加工に関する研究, *第56回応用物理学会学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.2,** *No.1a-TE-4,* 708, 2009年4月.
176. **井須 俊郎 :** 半導体多層膜共振器を用いた面型全光カーゲートスイッチ, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
177. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットの分子線エピタキシャル成長, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
178. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Akari Mukaijo, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in straiu-relaxed barriers for ultrafast all-optical switch, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.F4,* 155-156, Jul. 2009.
179. **Fumiya Tanaka, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Second harmonic and sum frequency generations of a coupled (113)B GaAs/AlAs multilayer cavity, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.J21,* 277-278, Jul. 2009.
180. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バイア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-2,** 97, 2009年8月.
181. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有するGaAs/AlAs結合共振器構造による周波数混合信号の発生, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-3,** 98, 2009年8月.
182. **出来 真斗, 山本 稔, 伊藤 拓人, 岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** イオン注入電極を作製したSiC基板へのフェムト秒レーザー照射による電気伝導特性制御, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会・講演予稿集,* 1057, 2009年9月.
183. **北田 貴弘, 田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜結合共振器内部における2つの共振器モードの光干渉効果, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-5,* 1286, 2009年9月.
184. **高橋 朋也, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/Air 多層膜共振器の光カー信号強度のシミュレーション, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-2,* 1285, 2009年9月.
185. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs (113)B 結合共振器における和周波信号強度の励起偏光方向依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-6,* 1287, 2009年9月.
186. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器におけるps パルスを用いた光カー信号のQ 値依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-1,* 1285, 2009年9月.
187. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 走査型プローブ顕微鏡リソグラフィーによる回折格子型表面プラズモン励起素子の作製, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9a-ZM-6,* 946, 2009年9月.
188. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだSi ドープInAs 量子ドットにおけるキャリア緩和の励起波長依存性, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-14,* 315, 2009年9月.
189. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜共振器における光カー信号の励起光強度依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-13,* 314, 2009年9月.
190. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜の励起子非線形光学応答制御における第一パルス光強度依存性, *日本物理学会2009年秋季大会, No.27aPS-28,* 2009年9月.
191. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の双極子モーメント, *第20回光物性研究会, No.A-83,* 341, 2009年12月.
192. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 山本 稔, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** 6H-SiC基板へのフェムト秒レーザー改質による電気伝導のパルスピッチ依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.18,** 148-149, 2009年12月.
193. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットをもつGaAs/AlAs多層膜光共振器による面型全光スイッチ, *2010年光エレクトロニクス研究会,* **Vol.109,** *No.401,* OPE2009-189, 2010年1月.
194. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットにおける高速キャリア緩和, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17p-TW-14,* 2010年3月.
195. **田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有する(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器の時間分解和周波信号測定, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17a-TM-22,* 2010年3月.
196. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** 回折格子型表面プラズモンポラリトン励起素子の特性, *第57回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.17a-P1-21,** 2010年3月.
197. **森田 健, 田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2パルスによる(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の和周波・第二高調波スペクトルの遅延時間依存性, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-M-1,* 2010年3月.
198. **森田 健, 高橋 朋也, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ピコ秒パルスを用いたInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造の光カー信号, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-N-7,* 2010年3月.
199. **高橋 朋也, 田中 文也, 張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングによるGaAs/Air多層膜共振器構造の作製, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-TM-24,* 2010年3月.
200. **森田 健 :** GaAs/AlAs非結合・結合共振器構造を利用した非線形ダイナミクス, *イーグル若手研究会,* 2010年3月.
201. **北田 貴弘 :** InAs量子ドットとGaAs/AlAs多層膜共振器構造の超高速光スイッチ, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
202. **森田 健 :** 多層膜結合光共振器構造による周波数混合信号の発生, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
203. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong Sum Frequency Generation in a GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity Grown on a (113)B-Oriented GaAs Substrate, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG01, 2010.
204. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Planar-Type Optical Kerr Gate Switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG02, 2010.
205. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strongly Enhanced Sum Frequency Generation in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.7,* 072801, 2010.
206. **Ken Morita, Nobuyoshi Niki, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2482-2485, 2010.
207. **Toshiro Isu, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2478-2481, 2010.
208. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2540-2543, 2010.
209. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Takuya Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2505-2508, 2010.
210. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of photocarrier relaxation in Si-doped InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 334-336, 2011.
211. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 378-380, 2011.
212. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Dephasing of excitonic polaritons confined in GaAs thin films, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.80,** *No.3,* 034704-1-034704-5, 2011.
213. **Manato Deki, Takuto Ito, Minoru Yamamoto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Enhancement of local electrical conductivities in SiC by femtosecond laser modification, *Applied Physics Letters,* **Vol.98,** *No.13,* 133104-1-133104-3, 2011.
214. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *World Academy of Science Engineering and Technology,* **Vol.74,** 24-28, 2011.
215. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong optical Kerr gate signal in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a picosecond laser pulse, *Quantum Dot 2010, No.p.57,* East Midlands Conference Center,Nottingham,UK, Apr. 2010.
216. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrE1-4,* 353, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
217. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation Wavelength Dependence of Photocarrier Relaxation in Si-Doped InAs Quantum Dots with Strain-Relaxed InGaAs Barriers, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP15,* 377, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
218. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Enhanced Sum-Frequency Generation Signal in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP18,* 379, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
219. **Toshiro Isu, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Toshikazu Takimoto, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Frequency-M-xing-Signal Generation on a GaAs/AlAs Coupled Multilayer-Cavity, *9th International Conference on Excitonic and Photonic Processws in Condensed and Nano Materials (EXCON'10),* **Vol.13O02,** Novotel Hotel, Brisbane, Australia, Jul. 2010.
220. **Manato Deki, Minoru Yamamoto, Ito Takuto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Femtosecond laser modification aiming at the enhancement of local electric conductivities in SiC, *30th International Conference on the Physics of Semiconductors,* P1-306, Seoul, Jul. 2010.
221. **Takahiro Kitada, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked reduction in photocarrier lifetime by erbium doping into self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *16th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2010), No.p1.20,* bcc Berlin Congress Center, Berlin, Germany, Aug. 2010.
222. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Flockert Michael, Toshihiro Okamoto, Masuo Fukui, Toshiro Isu, T Okazaki *and* Gen-ichi Shinomiya :** Modulator for Surface Plasmon Polariton Using LiNbO3:Ti Plasmon Waveguide, *11th International Conference on Near-field Nano Optics, Nanophotonics& Related Techniques (NFO-11),* Beijing, Aug. 2010.
223. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Remarkable Enhancement of Optical Kerr Signal by increasing Quality Factor in a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-1-4,* 59-60, Tokyo, Sep. 2010.
224. **Fumiya Tanaka, Toshikazu Takimoto, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-Resolved Measurements on Sum Frequency Generation Strongly Enhanced in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-2-1,* 61-62, Tokyo, Sep. 2010.
225. **Manato Deki, Takuro Ito, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Oshima :** Laser Modification Aiming at the Enhancement of Local Electrical Conductivities in SiC, *The 9th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Applications,* 218-221, Takasaki, Oct. 2010.
226. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel terahertz emission devices based on efficient optical frequency conversion in GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures on high-index substrates, *SPIE Photonics West2011, No.OPTO7937-52,* The Moscone Center San Francisco, California, USA, Jan. 2011.
227. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics (ICNOP) 2011,* 24, PENANG,MALAYSIA, Feb. 2011.
228. **原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** ナノLEDの開発, *LED総合フォーラム論文集,* 67-68, 2010年4月.
229. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of sum-frequency generation in a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-5,* 57, Jul. 2010.
230. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr gate switching in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a wavelength restricted picosecond laser pulse, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-7,* 61, Jul. 2010.
231. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したレジスト厚計測, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-5,* 2010年7月.
232. **田辺 新平, 中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したグルコースセンサー, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-4,* 2010年7月.
233. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *第71 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* 04-269, 2010年9月.
234. **森田 健, 田中 文也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分極反転したGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.14a-G-3,* 05-041, 2010年9月.
235. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの電気特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.15a-ZV-4,* 15-058, 2010年9月.
236. **田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 非対称なGaAs/AlAs多層膜結合共振器の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-7,* 14-070, 2010年9月.
237. **北田 貴弘, 田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器における非線形分極構造の制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-6,* 14-069, 2010年9月.
238. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜におけるレーザースペクトル幅制御による励起子応答制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-8,* 14-071, 2010年9月.
239. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのスラブ導波路上の位相シフト回折格子結合器の評価, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.17a-NJ-6,* 03-140, 2010年9月.
240. **五井 恵太, 山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の制御性, *2010年秋季大会 日本物理学会, No.25pPSB-31,* 731, 2010年9月.
241. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー改質したSiCにおける局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 114-115, 2010年10月.
242. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射偏光依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 110-111, 2010年10月.
243. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子応答に対する検出パルスのスペクトル幅の効果, *WINPTech2010 Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2010,* 2010年12月.
244. **五井 恵太, 小島 磨, 山下 太香恵, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の光制御, *第21回光物性研究会(2010), No.A-57,* 2010年12月.
245. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 検出パルス制御によるGaAs薄膜中の閉じ込め励起子の超高速応答, *第21回光物性研究会(2010), No.A-84,* 2010年12月.
246. **森田 健 :** 量子ドットを用いた面型多層膜超高速全光スイッチ, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
247. **北田 貴弘 :** 半導体結合光共振器によるテラヘルツ光発生素子, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
248. **森田 健, 加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 多層膜結合共振器構造へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24a-KF-4,* 04-157, 2011年3月.
249. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの作製とその光学特性, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24p-BQ-4,* 15-061, 2011年3月.
250. **西中 一平, 美藤 邦彦, 木股 雅章, 内藤 聖貴, 山本 泰志, 片山 晴善, 佐藤 亮太, Patrashin Mikhail, 寳迫 巌, 井須 俊郎, 北田 貴弘 :** GaSb/InAs Type-II超格子赤外線センサの開発, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KT-7,* 03-063, 2011年3月.
251. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 重心運動閉じ込め励起子の量子ビートの生成と検出, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-7,* 14-040, 2011年3月.
252. **北田 貴弘, 安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜三結合共振器の面型波長変換素子への応用, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-8,* 14-041, 2011年3月.
253. **滝本 隼主, 加藤 翔, 田中 文也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合により作製したGaAs/AlAs多層膜結合共振器, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-9,* 14-042, 2011年3月.
254. **中田 智康, 中河 義典, 田邉 新平, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのブレーズド回折格子結合器の評価, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-3,* 03-188, 2011年3月.
255. **田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 二次元六方クラスター回折格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-4,* 03-189, 2011年3月.
256. **Michael Flockert, 田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 小山 浩司, 四宮 源市 :** 二次元矩形クラスタープラズモニック格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-5,* 03-190, 2011年3月.
257. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射偏光依存性, *第58回応用物理学関係連合講演会,* 04-287, 2011年3月.
258. **加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の二つの共振器モードを利用したテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.26a-KB-2,* 05-106, 2011年3月.
259. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射強度および偏光依存性, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム 「日亜寄附講座研究成果報告会」,* 10, 2011年2月.